

证书号第 3658351 号



发明专利证书

发明名称：全 MOS 基准电流产生电路

发明人：李振荣；段艺明；王泽渊；刘博宇；周永升；庄奕琪

专利号：ZL 2018 1 1366488.4

专利申请日：2018 年 11 月 16 日

专利权人：西安电子科技大学

地址：710071 陕西省西安市雁塔区太白南路 2 号

授权公告日：2020 年 01 月 07 日

授权公告号：CN 109164867 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面